

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 27 年 5 月 28 日 (2015.5.28)

【公開番号】特開 2014-130853 (P2014-130853A)

【公開日】平成 26 年 7 月 10 日 (2014.7.10)

【年通号数】公開・登録公報 2014-037

【出願番号】特願 2012-286366 (P2012-286366)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

C 0 9 J 4/00 (2006.01)

C 0 9 J 5/00 (2006.01)

C 0 9 J 5/06 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 2 J

C 0 9 J 4/00

C 0 9 J 5/00

C 0 9 J 5/06

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 4 月 14 日 (2015.4.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(A) フッ素原子又はシリコン原子を有するラジカル重合性モノマー又はオリゴマー、
(B) 高分子化合物、及び、(C) ラジカル重合開始剤を含有する半導体装置製造用仮接着剤。

【請求項 2】

更に、(D) 前記ラジカル重合性モノマー又はオリゴマー (A) とは異なる、ラジカル重合性モノマー又はオリゴマーを含有する、請求項 1 に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

【請求項 3】

前記ラジカル重合性モノマー又はオリゴマー (A) が、2 個以上のラジカル重合性官能基を有する、請求項 1 又は 2 に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

【請求項 4】

前記ラジカル重合性モノマー又はオリゴマー (A) が、フッ素原子を有するモノマー又はオリゴマーである、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

【請求項 5】

前記ラジカル重合開始剤 (C) が、光ラジカル重合開始剤である、請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

【請求項 6】

前記ラジカル重合開始剤 (C) として、光ラジカル重合開始剤と熱ラジカル重合開始剤とを含有する、請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

【請求項 7】

基板と、前記基板上に、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤により形成された接着性層とを有する接着性支持体。

【請求項 8】

被処理部材の第 1 の面と基板とを、請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤により形成された接着性層を介して接着させる工程、

前記被処理部材の前記第 1 の面とは異なる第 2 の面に対して、機械的又は化学的な処理を施し、処理済部材を得る工程、及び、

前記接着性層から前記処理済部材の第 1 の面を脱離する工程を有する、前記処理済部材を有する半導体装置の製造方法。

【請求項 9】

前記被処理部材の第 1 の面と基板とを前記接着性層を介して接着させる工程の前に、前記接着性層の、前記被処理部材の第 1 の面に接着される面に対して、活性光線若しくは放射線又は熱を照射する工程を更に有する、請求項 8 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 10】

被処理部材の第 1 の面と基板とを前記接着性層を介して接着させる工程の後、かつ、前記被処理部材の前記第 1 の面とは異なる第 2 の面に対して、機械的又は化学的な処理を施し、処理済部材を得る工程の前に、前記接着性層を 50 ～ 300 の温度で加熱する工程を更に有する、請求項 8 又は 9 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 11】

前記接着性層から前記処理済部材の第 1 の面を脱離する工程が、前記接着性層に剥離液を接触させる工程を含む、請求項 8 ～ 10 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 12】

前記被処理部材が、被処理基材と、前記被処理基材の第 1 の面の上に設けられた保護層とを有してなり、

前記保護層の、前記被処理基材とは反対側の面を、前記被処理部材の前記第 1 の面とし、

前記被処理基材の前記第 1 の面とは異なる第 2 の面を、前記被処理部材の前記第 2 の面とする、請求項 8 ～ 11 のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

〔1〕

(A) フッ素原子又はシリコン原子を有するラジカル重合性モノマー又はオリゴマー、
(B) 高分子化合物、及び、(C) ラジカル重合開始剤を含有する半導体装置製造用仮接着剤。

〔2〕

更に、(D) 前記ラジカル重合性モノマー又はオリゴマー(A)とは異なる、ラジカル重合性モノマー又はオリゴマーを含有する、上記〔1〕に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

〔3〕

前記ラジカル重合性モノマー又はオリゴマー(A)が、2個以上のラジカル重合性官能基を有する、上記〔1〕又は〔2〕に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

〔4〕

前記ラジカル重合性モノマー又はオリゴマー(A)が、フッ素原子を有するモノマー又はオリゴマーである、上記〔1〕～〔3〕のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

〔5〕

前記ラジカル重合開始剤(C)が、光ラジカル重合開始剤である、上記〔1〕～〔4〕

のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

〔 6 〕

前記ラジカル重合開始剤 (C) として、光ラジカル重合開始剤と熱ラジカル重合開始剤とを含有する、上記〔 1 〕～〔 5 〕のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤。

〔 7 〕

基板と、前記基板上に、上記〔 1 〕～〔 6 〕のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤により形成された接着性層とを有する接着性支持体。

〔 8 〕

被処理部材の第 1 の面と基板とを、上記〔 1 〕～〔 6 〕のいずれか 1 項に記載の半導体装置製造用仮接着剤により形成された接着性層を介して接着させる工程、

前記被処理部材の前記第 1 の面とは異なる第 2 の面に対して、機械的又は化学的な処理を施し、処理済部材を得る工程、及び、

前記接着性層から前記処理済部材の第 1 の面を脱離する工程
を有する、前記処理済部材を有する半導体装置の製造方法。

〔 9 〕

前記被処理部材の第 1 の面と基板とを前記接着性層を介して接着させる工程の前に、前記接着性層の、前記被処理部材の第 1 の面に接着される面に対して、活性光線若しくは放射線又は熱を照射する工程を更に有する、上記〔 8 〕に記載の半導体装置の製造方法。

〔 10 〕

被処理部材の第 1 の面と基板とを前記接着性層を介して接着させる工程の後、かつ、前記被処理部材の前記第 1 の面とは異なる第 2 の面に対して、機械的又は化学的な処理を施し、処理済部材を得る工程の前に、前記接着性層を 50 ～ 300 の温度で加熱する工程を更に有する、上記〔 8 〕又は〔 9 〕に記載の半導体装置の製造方法。

〔 11 〕

前記接着性層から前記処理済部材の第 1 の面を脱離する工程が、前記接着性層に剥離液を接触させる工程を含む、上記〔 8 〕～〔 10 〕のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。

〔 12 〕

前記被処理部材が、被処理基材と、前記被処理基材の第 1 の面の上に設けられた保護層とを有してなり、

前記保護層の、前記被処理基材とは反対側の面を、前記被処理部材の前記第 1 の面とし、

前記被処理基材の前記第 1 の面とは異なる第 2 の面を、前記被処理部材の前記第 2 の面とする、上記〔 8 〕～〔 11 〕のいずれか 1 項に記載の半導体装置の製造方法。